⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-69247

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)3月30日

G 02 F

1/31 1/055 A - 7348 - 2H C - 7448 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 光スイツチ

> ②特 頭 昭60-209132

223出 顋 昭60(1985) 9月20日

⑫発 明 者 福 \blacksquare

宜 代 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社內

明 73発 者

明者

勿発

野

隆 攻

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

①出 顖 人 松下電器産業株式会社

東

門真市大字門真1006番地

30代 理 弁理士 中尾 触男 外1名

1、発明の名称 光スイッチ

2、特許請求の範囲

- (1) 基板上に形成した電気光学効果を有する薄膜 と、前記薄膜袋面に帯型の前記薄膜よりなる凸部 を形成して構成した少なくとも2本の互いに交差 する光導波路と、前記薄膜より小さい屈折率を有 するパッファ層と、前記パッファ層上に形成され た光路切り換え用の制御電極を備え、前記光導波 路の入力及び出力導放路の近傍に、前記パッファ 層より屈折率の高い導波路プリズムを配置したと とを特徴とする光スイッチ。
- (2) 電気光学効果を有する薄膜が PLZ T系薄膜 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 敬の光スイッチ。
- (3) 導波路プリズムが電気光学効果を有する薄膜 に段差を設けて形成されたことを特徴とする特許 請求範囲の第2項記載の光スイッチ。
- (4) 導波路ブリズムが、Ta₂O₅, Nb₂O₅, Aℓ₂O₃,

酸化イットリウム,酸化チタニウム,SIO2等の 透明高屈折率材料,薄膜を積層して形成されると とを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の光ス

- (5) 導波路プリズムを形成する薄帯が、Si.GaAs. InAs, InSb 等の不透明高屈折率材料であること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の光スイ
- (a) 導放路プリズムにグレーティングを施したこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光ス 1 " + "

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光通信,光応用計測,光情報処理等 の分野に利用される光スイッチに関するものであ **3** .

従来の技術

近年光ファイバ通信計測等において、光路を切 り換える光スイッチ素子が重要なキーデバイスと して研究開発されてきている。なかでも、導皮路 光スイッチ素子は数GHz以上の高速応答性を示す ことで特に関心が集まっている。特にTIR(内 部全反射型)と呼称される導波路光スイッチは素 子が小型で高速性に富むといわれ脚光を浴びてい る。

第2図には従来例を示す、基板22上に設けられた交差導波路21上に屈折率の低いパッファッを介して制御電医24を形成した構造で、リッッを入力導波路21につながる入力導波路21aと、出間に電圧を印加しない場合、入力導波路21aと導波する。は直後と、出力導波路21bを経て、光ファイバ26へと伝送を記した送達な路の光を1は電医24による。電圧を印加すると光導波路の光を1は電医24による電圧を印加すると光導波路の光を1は電医24による電圧を印加すると光導波路の光を1は電医24による電圧を印加すると光導波路の光を1は電医24による電気光学効果により出力導波路21cを導放し、光ファイバ25へ光スイッチと、電気光学効果により出力導放路21cを導放し、光スイッチとに伝送路している。(特顧昭59-113318号

発明が解決しようとする問題点

示す要部平面図である。第1図の光スイッチは、 据板上に電気光学効果を有する透明薄膜12から なる交差光導放路11を形成した後光導波路11 および透明薄膜12を覆うようにバッファ層を設 けてある。上記光導波路11は、薄膜12表面に 帝型の上記薄膜12より成る凸部を形成したリッ ジ型導波路である。

本実施例では、入力,出力ともに2本ずつの光導波路を設けてある。2組の入力,出力光導液路の光力の光力の光力がある。2組の入力,出力光導度はり高い屈折率をもつブリズム領域117が、薄膜12上に形成されている。パッファ層を介して、導速路交叉部上に狭い電極ギャップ141を有力薄膜14を具備し、ギャップ141は直下部分の薄膜12が2組の入出力光導液路端部を結ぶ交差線の二等分線上に来るように配置されている。電極14に電圧を印加した時にスイッチすることになる。

本実施例において、電気光学材料薄膜 1 2 t P L Z T (X/Y/Z) 薄膜 $Pb_1-\frac{x}{100}$ La $\frac{x}{100}$ ($Zx\frac{y}{100}$ T₁ $\frac{x}{100}$) 1 $-\frac{x}{400}$ O₃, O \leq X , Y ,

このような従来の光スイッチでは光入力部での 伝送光 ℓ 1 は光結合効率 1 が 1 でないため、光導 破路 2 1 a 以外にも伝搬し、第2図に示すように 光 ℓ 1 が発生した。光 ℓ 1 は光出力部の光ファイ パ 2 6 に伝送され、消光比、分岐比を低下させる という問題点を有していた。

問題点を解決するための手段

本発明は上記問題点を解決するため、リッジ型 光導波路の入力部及び出力部の近傍にパッファ層 より屈折率の高いプリズム領域を設けて光 ℓ1′を 屈折させて伝搬方向を変え、出力光導波路近傍を 伝搬しないようにするものである。

作 用

本発明は上記した構成により、導放路モード以外のモードを導放路ブリズムにおいて屈折させ、 その進行方向を変えることで、導成モード以外の モードの光ファイバへの伝送を防ぐため、消光比, 分岐比の優れた光スイッチが実現できる。

実 施 例

第1図は本発明の光スイッチ素子の一実施例を

2≦100, y+2=100) を用いた。実際には サファイヤ基板上にPLZT(28/0/100) 組成のターゲットを用いてブレーナマグネトロン ・スパッタ法により、PLZT薄膜12を単結晶 成長させた。膜厚は、O.35 μm であった。次に、 このPLZT系薄膜12の表面を光導波路幅20 μ皿,交差角2°となるように、フェトレジスト でマスキングして、PLZT采薄膜12をイォン ビームエッチング法により50nmだけェッチン グを施した。このように加工するとリッジ部を有 する導波路11が形成され、光はリッジ部を有す る導波路に閉じ込められて伝搬することが可能と なる。次にPLZT系薄膜12上にTa₂0₅をリ フトオフ法でプリズム領域17となるようにバタ ーン出しを行い、エッチングによりグレーティン グを施した上にAl₂O₃ 添加のTa₂O₅ を 0.18 mmパッファ層としてスパッタ形成した。 PIZT 系薄膜の屈折率は 2.6 、 Ta₂O₅ 膜の屈折率は 2.1、 Al₂O₃ 添加の Ta₂O₅ 膜の屈折率は 2.0 であった。 その上にギャップ4µm,幅11.7mm,長さ2mm

の平行電値14を交差部中央に来るようにAℓを リストオフ法でパターン形成した。入力光導波路 となるロード11 aの一端から1.3 μmの半導体 レーザ光を入射させて出力光導波路からの光出力 をした。この結果、スイッチ電圧4.7 V 消光 比15 dBが得られ、従来のものに較べて5 dB 以上ードが屈折率の高いは、発生したスラブに より屈折し、導波路を一ドへの影響が持られた からである。又導波路をプリズムにグレーティンが出 をよりに光ファイパ13,16 である。さらに光ファイパ13,16 である。 での入出力においても、消光比の改善が得られ、 分岐比も改善されている。

なお本実施例では、電気光学材料としてPLZT (28/0/100)のターゲット組成から得られたPLZT膜について述べたが、電気光学特性を示す全ての組成のものを使用することが出来る。バッファ層には $A\ell_2O_3$ 添加の Ta_2O_5 を用いたが、これに限定することなく、 Nb_2O_5 , $A\ell_2O_3$,

1 1 ……光導波路、1 2 ……電気光学材料薄膜、1 3 , 1 5 , 1 6 ……光ファイバ、1 4 ……電極、1 4 1 ……電極ギャップ、1 7 ……導波路プリズム。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名 酸化イットリウム,酸化チタニウム,SIO₂ 等々 電気光学薄膜より屈折率が低く透明な膜であれば 何でもよい。

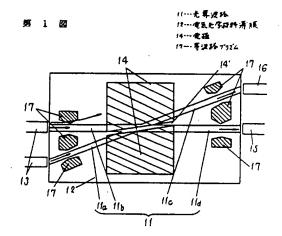
また導放路ブリズム領域17にはTa_xO₆を用いたがこれはパッファ層よりも屈折率が高いものでNb₂O₅, Al₂O₃ 酸化イットニウム酸化チタニウム, SiO₂ 等の透明材料、また, Si, GaAa, Ge, InAa, InSb, InP, CdTe 等の不透明材料でもよい。さらにPL2T薄膜に改差を設け実効屈折率を高くして形成したものでも同様の効果がみられる。

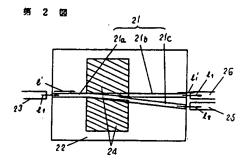
発明の効果

本発明により、導放路モード以外のモード発生による消光比,分岐比の低下という問題をグレーティングを施した導放路ブリズム領域の設置により、消光比,分岐比の低下を改善したもので産業上の効果は大なるものである。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の光スイッチの一実施例を示す 要部平面図、第2図は従来の光スイッチの概略平 面図である。







PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62069247 A

(43) Date of publication of application: 30 . 03 . 87

(51) Int. CI

G02F 1/31

G02F 1/055

(21) Application number: 60209132

(22) Date of filing: 20 . 09 . 85

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

FUKUDA TOMIYO TONO HIDETAKA

YAMAZAKI OSAMU

(54) OPTICAL SWITCH

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical switch which is superior in quenching ratio and branch ratio by refracting light in mode other than the mode of a waveguide by a waveguide prism, and changing the traveling direction of the light and preventing it from being transmitted to an optical fiber in mode other than the waveguide mode.

CONSTITUTION: A crossing optical waveguide 11 made of a transparent thin film 12 having electrooptic effect is provided on a substrate and then a buffer layer is formed so as to cover the optical waveguide 11 and transparent electrode 12. The optical waveguide 11 is a ridge waveguide which have a projection part formed of the beltlike thin film 12 on the surface of the thin film 12. A prism are 17 which has a higher refractive index than the buffer layer is formed on the thin film 12 in the vicinity of the light input and output parts of two input and output light waveguides, an electrode 14 which has a narrow electrode gap 14' on the waveguide intersection part is provided across the buffer layer, and the gap 14' is so positioned that the thin film 12 right below it is on the bisector of the intersection line connecting the two input and output waveguide end parts. When a voltage is applied to an

electrode 14, this switch operates.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

